

ナノプローブテクノロジー 第167委員 第81回研究会

半導体への顕微鏡応用最前線 (SPM、ホログラフィ、AP、HIM)

日時：2016年1月12日(火) 13:00~17:10

場所：東京大学(駒場キャンパス 総合研究実験棟(An棟) コンベンションホール)

- 13:00 事務連絡など
- 13:10-13:55 半導体デバイスの故障解析の現状と今後
浜松ホトニクス、嶋瀬朗
- 13:55-14:30 SNDMによる次世代半導体デバイス向け新材料評価
東北大学、長康雄
- 14:30-15:05 電子線ホログラフィを用いた微細トランジスタのその場動作観察
名古屋大学、五十嵐信行
- 15:05-15:25 Coffee break
- 15:25-16:00 特定個所・高空間分解能・高感度SSRMによるキャリア分布計測技術
東芝、張利
- 16:00-16:35 3次元アトムプローブ法の半導体応用の現状と最近の話題
東北大学、清水康雄
- 16:35-17:10 ヘリウムイオン顕微鏡技術による評価と加工
産業技術総合研究所、小川真一
- 17:30 懇親会、An棟1階、カポペリカーノ

企画委員

金沢工業大学 二川清

東芝 白田宏治

東京大学 川勝英樹